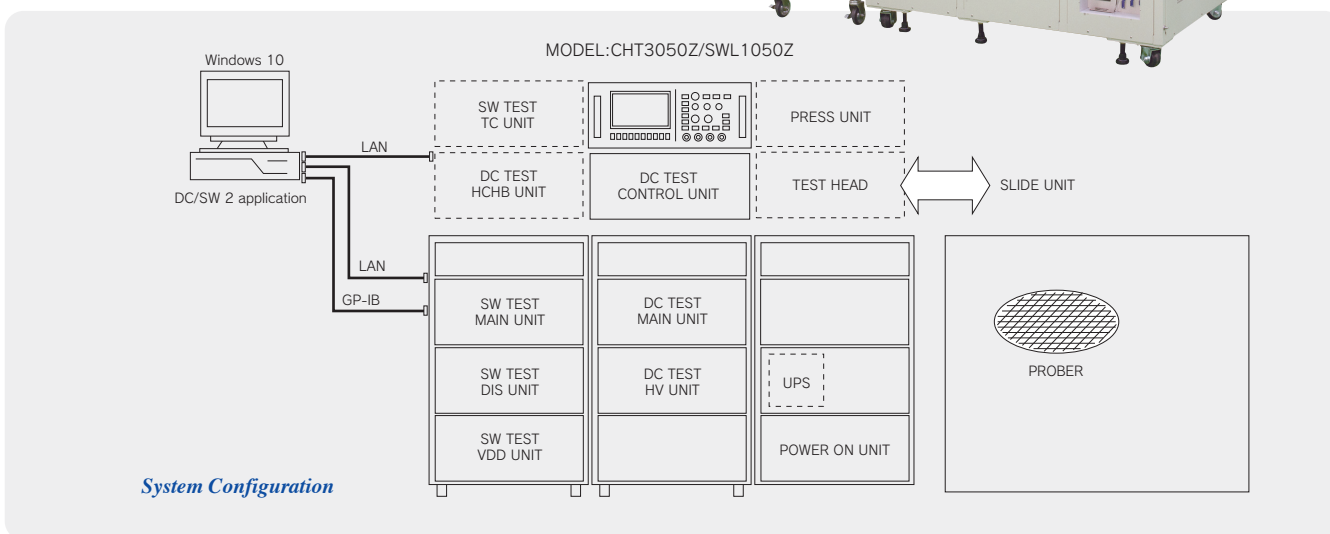


SEMICONDUCTOR TEST SYSTEM / SWITCHING TIME TEST SYSTEM  
 半導体テストシステム/スイッチングタイムテストシステム

CHT3050Z/SWL1050Z 3000V 500A

- CHT3050Z/SWL1050Z has been designed to evaluate a wafer which is able to measure DC and switching characteristics at once. This system is equipped with a press control unit to control by measurement program. An oscilloscope for checking waveforms is built in and users can check it at any time.
- 本システムはウエハ評価用のテストシステムで、DC特性とスイッチング特性を一度の測定で行うことができます。また加圧制御機構も装備し測定プログラムで任意に制御することができます。波形確認用のオシロスコープは内蔵されており、必要なときにいつでも波形チェックが行えます。



| MODEL                                |                           | CHT3050Z/SWL1050Z   |            |
|--------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| <b>SOFTWARE</b>                      |                           |   |            |
| TEST PLAN/SORT PLAN                  |                           | 1000/1000   |            |
| BIN OUT                              |                           | 24  |            |
| <b>DC TEST</b>                       |                           |   |            |
| MEASURABLE DEVICES                   |                           | N MOS-FET, N-IGBT, N-DIODE  |            |
| VOLTAGE/CURRENT                      |                           | 3000V/500A  |            |
| TEST ITEMS                           | MOS-FET                   | I <sub>DS</sub> , I <sub>DG</sub> , I <sub>GsX</sub> , I <sub>GSS</sub> , I <sub>GsG</sub> , B <sub>VDS</sub> , B <sub>VdG</sub> , B <sub>VsG</sub> , V <sub>FdG</sub> , V <sub>FgS</sub> , V <sub>FSDS</sub> , V <sub>FSDX+</sub> , V <sub>P</sub> , V <sub>TH</sub> , V <sub>TH2</sub> , V <sub>TH(HV)</sub> , V <sub>dSON</sub> , R <sub>dSON</sub> , L <sub>VDSON</sub> , L <sub>RDSON</sub> , I <sub>dON</sub> , D <sub>HIDSS</sub> , G <sub>MP</sub>  |            |
|                                      | IGBT                      | I <sub>CE</sub> , I <sub>GE</sub> , I <sub>EG</sub> , B <sub>VCE</sub> , I <sub>LGES+</sub> , I <sub>LGES-</sub> , V <sub>THGB1</sub> , V <sub>THGB2</sub> , V <sub>TH(HV)</sub> , V <sub>CEON</sub> , L <sub>VCEON</sub> , V <sub>FEC</sub> , G <sub>MP</sub> , V <sub>BLMK</sub> , V <sub>BLMK+</sub> , V <sub>BLMK-</sub> , V <sub>EmE</sub> , V <sub>EmE2</sub> , V <sub>EmER1</sub> , V <sub>Es1ECS</sub> , V <sub>EmER2</sub> , V <sub>GEm</sub> , I <sub>EmE1</sub> , I <sub>Es1ECES</sub> , I <sub>EmE2</sub> , B <sub>VCEmX2+</sub> , B <sub>VCEmX2-</sub> , B <sub>VGEsp</sub> , V <sub>GEI1</sub> , V <sub>GEI2</sub> , H <sub>ICEX(Ig)+</sub> , H <sub>ICEX(Ig)-</sub> , I <sub>CG</sub> , I <sub>CG+</sub> , I <sub>CG-</sub> , I <sub>CEX+</sub> , I <sub>CEX-</sub> , L <sub>IGE</sub> , I <sub>GE</sub> , I <sub>LCEEs</sub> , V <sub>CEsON</sub> , V <sub>CErON</sub> , I <sub>CEON</sub> , I <sub>AE</sub> , I <sub>EmA</sub> , B <sub>VEG+</sub> , B <sub>VEG-</sub> , I <sub>EsEm</sub> , I <sub>EmEs</sub> , B <sub>VEsEm+</sub> , B <sub>VEsEm-</sub> , I <sub>KE</sub> , I <sub>GEs</sub> , I <sub>GEr</sub> , I <sub>DSX(Ig)+</sub> , I <sub>DSX(Ig)-</sub> |            |
|                                      | DIODE                     | V <sub>R</sub> , I <sub>R</sub> , L <sub>IR</sub> , V <sub>F</sub> , L <sub>VF</sub> , I <sub>F</sub> , V <sub>FCD</sub> , V <sub>RD</sub> , I <sub>RD</sub> , L <sub>IRD</sub> , V <sub>FD</sub> , L <sub>VFD</sub> , Th <sub>DiVf</sub> , Th <sub>DiIz</sub> , Th <sub>DiVz</sub> , L <sub>ThDiIz</sub>   |            |
| <b>SWITCHING TEST</b>                |                           |   |            |
| MEASURABLE DEVICES N MOS-FET, N-IGBT |                           |   |            |
| TEST ITEMS                           | L-SWITCHING               | I <sub>d</sub> , V <sub>d</sub> , V <sub>g</sub> , t <sub>d(on)</sub> , t <sub>r</sub> , t <sub>d(off)</sub> , t <sub>f</sub> , e <sub>(on)</sub> , e <sub>(off)</sub> , di/dt <sub>(on)</sub> , di/dt <sub>(off)</sub> , dv/dt <sub>(on)</sub> , dv/dt <sub>(off)</sub> , I <sub>dp</sub> , V <sub>dsp</sub> , I <sub>g(on)</sub> , I <sub>g(off)</sub> , V <sub>sep</sub> , di/dt   |            |
|                                      | AVALANCHE                 | I <sub>rr</sub> , V <sub>rr</sub> , t <sub>rr</sub> , t <sub>rr-a</sub> , t <sub>rr-b</sub> , Q <sub>rr</sub> , di <sub>f</sub> /dt, di <sub>r</sub> /dt, Err, I <sub>F</sub> , V <sub>rpp</sub>  |            |
|                                      | Di-AVAL                   | V <sub>d</sub> , V <sub>g</sub> , t <sub>d(off)</sub> , t <sub>f</sub> , di/dt <sub>(off)</sub> , dv/dt <sub>(off)</sub> , I <sub>dp</sub> , V <sub>dsp</sub> , Ear   |            |
| SETTING RANGE                        | V <sub>DD</sub>           | 10V~999V  | 1V STEP    |
|                                      | V <sub>GF/VGR</sub>       | ±0V~±29.9V  | 0.1V STEP  |
|                                      | I <sub>D</sub> (Limit)    | 1A~500A   | 1A STEP    |
|                                      | V <sub>D</sub> (Limit)    | 5V~999V   | 1V STEP    |
|                                      | X-Bias                    | 0V~29.9V  | 0.1V STEP  |
|                                      | Time-1                    | 000.0μs~999.9μs   | 0.1μs STEP |
|                                      | Time-2/Time-3             | 00.0μs~99.9μs   | 0.1μs STEP |
|                                      | Load coil                 | 50μH, 100μH, 500μH, 1mH   |            |
|                                      | R <sub>g</sub> resistance | 0.0Ω~25.5Ω  | 0.1Ω STEP  |
| <b>DIMENSIONS &amp; WEIGHT</b>       |                           |   |            |
| MAIN UNIT                            |                           | 1700(W)×1000(D)×1733(H)~900kg   |            |